

2SA1306/1306A/1306B

シリコンPNPエピタキシャル形
トランジスタ(PCT方式)

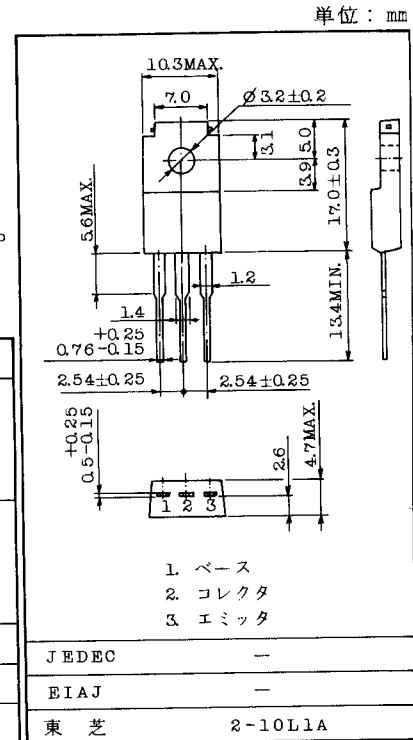
- 電力増幅用
- 励振段電力増幅用

特長

- ・ トランジション周波数が高い。: $f_T=100\text{MHz}$ (標準)
- ・ 2SC3298, 2SC3298A, 2SC3298Bとコンプリメンタリになります。

最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	2SA1306	-160	V
	2SA1306A	-180	
	2SA1306B	-200	
コレクタ・エミッタ間電圧	2SA1306	-160	V
	2SA1306A	-180	
	2SA1306B	-200	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-1.5	A
ベース電流	I_B	-0.15	A
コレクタ損失 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	P_C	20	W
接合温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタしゅ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-160\text{V}, I_E=0$	—	—	-1.0	μA
エミッタしゅ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5\text{V}, I_C=0$	—	—	-1.0	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-10\text{mA}, I_B=0$	-160	—	—	V
			-180	—	—	
			-200	—	—	
直流電流増幅率	h_{FE} (注)	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-100\text{mA}$	70	—	240	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}, I_B=-50\text{mA}$	—	—	-1.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-500\text{mA}$	—	—	-1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=-10\text{V}, I_C=-100\text{mA}$	—	100	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}, I_C=0, f=1\text{MHz}$	—	30	—	pF

注: h_{FE} 分類 O: 70~140, Y: 120~240